## **SCRIBING DEVICE**

Patent number:

JP57107052 1982-07-03

**Publication date:** Inventor:

KANEKO TOSHIAKI

Applicant:

FUJITSU LTD

Classification:

- international:

H01L21/301; H01L21/78; H01S5/00; H01L21/70; H01L21/70; H01S5/00; (PC1-7): H01L21/78

- european:

H01L21/78

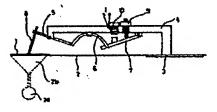
Application number: JP19800184735 19801225

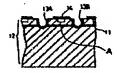
Priority number(s): JP19800184735 19801225

Report a data error here

## Abstract of JP57107052

PURPOSE: To enable mechanizing of a cutting process for a laser wafer, by a method wherein a pressing PURPOSE:To enable mechanizing of a cutting process for a laser wafer, by a method wherein a pressing member provided with an adjusting member is mounted at a support arm moving in a manner to hold a diamond cutter, and a pressing force is regulated corresponding to a cutting region. CONSTITUTION:A wafer 1 is securely sucked to a table 2 by means of a vacuum chuck 2b, A cutter supporting member 5 is installed to a support axe 4 through a support arm 7 and a spring 6, a press force is exerted on a diamond cutter through the adjustment of a spring 9, and the wafer 1 is scribed through the movement of a guide 3. Through the installation of an electromagnet 10 at the support axe 4, a force in a reverse direction to that of the spring 9 is exerted at an energizing time, and this permits a cutter 8 to be reduced in the press force. In case a GaAs laser wafer, formed in a mess stripe structure and having a luminous region A, is cut, the press force is caused to decrease through the operation of the electromagnet 10 at a point of time when the cutter 8 passes through the luminous region A. This permits laser wafer cutting to be mechanized and mass-produced. mass-produced.





Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

C.ted Ref 2

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭57—107052

⑤Int. Cl.³
H 01 L 21/78

識別記号

庁内整理番号 7131-5F **43公開** 昭和57年(1982)7月3日

発明の数 1 審査請求 有

(全 3 頁)

60スクライビング装置

②特

願 昭55-184735

@出

頁 昭55(1980)12月25日

⑫発 明 者 金子敏明

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

⑪出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

個代 理 人 弁理士 松岡宏四郎

明細音

1. 発明の名称

スクライビング装置

2. 特許請求の範囲

ダイヤモンド刃と、 蚊ダイヤモンド刃を保持して移動する支持アームと、 該支持アームに取付けられた押圧付加部材とを有するスクライビング装置において、前記押圧付加部材に押圧調整部材を 併設したととを特徴とするスクライビング装配。

3. 発明の詳細な説明

本発明はスクライビング装置に保り、特に半導体レーザのウエハーの切り出しに好適なスクライビング装置に関するものである。

従来半導体ウェハーのスクライビング装置としてウェハーに一定荷重をかけたダイヤモンド刃を接触させ、該ダイヤモンド刃を移動させるスクライビング装置が用いられているが、ガリウム純菜(GaAs)半導体ウエハーのような化合物半導体ウェハーはシリコン(Si)等の半導体ウェハーに比べて材質が脆弱であるためスクライビング装置

を用いることは不適当で、通常カミソリ刃によつ て手動で切り出しを行つており極めて非生態的で あつた。

本希明の目的は前述の欠点を解消し量産的なスクライビング装置を提供することであり、かよる目的を達成するために本発明は従来のスクライビング装置の押圧付加部材に押圧調整部材を併設したことを特徴とするものである。

以下図面を用いて本発明に保る好ましい契約例について詳細に説明する。

第1図は本発明に係るスクライビング装置の一 実施例を示す概念図であつて、被処理ウエハー1 は敵物台2上におかれ、該取物台2には真空ポン プ2®の動作によりウエハー1を吸着固定する真 空チャック2月が配設されている。さらにガイド 3 は支持軸4を搭載して第1図の左右方向に往復 運動しながら一定ピッチで前後方向に移動するも ので、さらに支持軸4は先端部で切刃支持部が5 の中間部を揺動可能に支持し、かつ終端部で支持 フーム7の一端を回動可能に支持している。しか

特開昭 57 - 107052(2)

してパネ材 6 は一端は切刃支持部材 5 と、他端は 支持アーム 7 と連結し、かつ中間部は移動可能な 状態で支持軸 4 に保持されている。またダイヤモ ンド刃 8 は切刃支持部材 5 の先端に取付けられて いる。しかして支持和 4 に配設されたスプリング 9 を調整して支持アーム 7 を下方に移動させると、 パネ材 6 は引張られて切刃支持部材 5 との連結部 を引上げ、最終的にダイヤモンド刃 8 を下方に押 し下げるため押圧力が増加したことになる。また 電磁石 1 0 はスプリング 9 の押圧力に逆らうよ りな力が働き、ダイヤモンド刃 8 の押圧力を減少 させる。

とのような構造において配磁石10を除いた技 置が従来のスクライビング技置であつて、スプリ ング9のテンション調整によつてウェハー1に加 わるダイヤモンド刃8の押圧力が決定されるため 押圧力は常に一定である。 Siウェハーの場合に は問題なくスクライブできるがGeAsウェハーは Si ウェハーに比べて材質が脱弱で、スクライフ

する時のみパルス電流を第8図(a)の如く流すと押 圧力は第3図(b)の如くなりウエハーの発光領域を 損傷させずにスクライブすることができる。第3 図(c)は配配石10に電流を流さない場合(従来の スクライビング装置の場合)の押圧力の状況を示 す。

本発明社前記実施例に限定されることなくさらに極々変形して実施できる。たとえば電磁石10の他に静電的な反発力および吸引力を用いてもよいし、また機械的にカムを用いて発光領域に同期させて支持アーム7を浮かせて押圧力を減少させてもよい。

以上の説明から明らかなように本発明に係るスクフィビング接触は発光領域をスクフィブする時 に押圧力を弱くすれば従来人力にで特別していた 半導体レーザウエハーが機械化可能となり、量産 的で債額性のよいチップを製作することができる。

## 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明に係るスクライビング装置の一 実施例を示す概念図、第2図は半導体レーザの断 可能な押圧力をウェハーに加えると半導体レーザの範面を作成することが不可能となる。

ところが半海体レーザは紫2図の断でないたとくP.が接合面11をもつたP型の結晶をとくP.が接合面11をもつたP型の結晶をしたるができる。との形式として、絶縁暦13Aかよび13Bを被覆し、さらに電極14を被覆したものである。とのような半球体レーザーでは、Aの領域に電流が銀はして変けたを行うととになりその他の領域が非影光を行うととになりその他の領域が非影光を行うととになりその他の領域が非影光を行うととになりその他の可でがでにして、が発光で対する神圧力をウェハーが振くして、非発光領域には充分な神圧ウェルようにはスクライブ後のローリング工程でウェハーが完全に管闘して所望の素子が形成されるととなる。

したがつてスクライビング装置に電磁石10を 配設して電磁石10に電流を流して励磁すると、 支持アーム7が吸引され押圧力が減少するととか ち半導体レーザウエハーの発光領域をスクライブ

面図、第3図(a)は本発明に係るスクライビング装置の電磁石駆動電流の被形例、第3図(b)は第3図(a)の時の押圧力の変化例、第3図(c)は従来の押圧力の依である。

図において、1はウェハー、2は載物台、3はガイド、4は支持軸、5は切刃支持部材、6はパネ材、7は支持アーム、8はダイヤモンド刃、9はスプリング、10は電磁石である。

代理人 弁理士 松 岡 宏四郎 (中)

